



(11) **EP 1 523 771 B8**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE**

(15) Information de correction:

Version corrigée no 1 (W1 B1)
Corrections, voir
Bibliographie code(s) INID 73

(51) Int Cl.:

H01L 21/762 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international:

PCT/FR2003/002225

(48) Corrigendum publié le:

12.05.2010 Bulletin 2010/19

(87) Numéro de publication internationale:

WO 2004/010494 (29.01.2004 Gazette 2004/05)

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:

10.03.2010 Bulletin 2010/10

(21) Numéro de dépôt: **03750808.2**

(22) Date de dépôt: **15.07.2003**

(54) **PROCEDE DE TRANSFERT D'UNE COUCHE MINCE ELECTRIQUEMENT ACTIVE.**

VERFAHREN ZUR ÜBERTRAGUNG EINER DÜNNEN, ELEKTRISCH AKTIVEN SCHICHT
METHOD FOR TRANSFERRING AN ELECTRICALLY ACTIVE THIN LAYER

(84) Etats contractants désignés:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

(56) Documents cités:

WO-A-02/37556 US-A- 6 150 239

(30) Priorité: **18.07.2002 FR 0209118**

(43) Date de publication de la demande:

20.04.2005 Bulletin 2005/16

(73) Titulaires:

- **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE**
75015 Paris (FR)
- **S.O.I.Tec Silicon on Insulator Technologies**
38190 Bernin (FR)

- **HUGONNARD-BRUYERE E ET AL: "Electrical and physical behavior of SiC layers on insulator (SiCOI)" INTERNATIONAL CONFERENCE ON SILICON CARBIDE AND RELATED MATERIALS, ICSRM'99, RESEARCH TRIANGLE PARK, NC, USA, 10-15 OCT. 1999, vol. 338-342, pt.1, pages 715-718, XP008017315 Materials Science Forum, 2000, Trans Tech Publications, Switzerland ISSN: 0255-5476**
- **HUGONNARD-BRUYERE E ET AL: "Defect Studies in Epitaxial SiC-6H Layers on Insulator (SiCOI)" MICROELECTRONIC ENGINEERING, ELSEVIER PUBLISHERS BV., AMSTERDAM, NL, vol. 48, no. 1-4, septembre 1999 (1999-09), pages 277-280, XP004193305 ISSN: 0167-9317**
- **HUGONNARD-BRUYERE E ET AL: "Deep level defects in Implanted 6H-SiC epilayers and in silicon carbide on insulator structures" MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 61-62, 30 juillet 1999 (1999-07-30), pages 382-388, XP004363371 ISSN: 0921-5107**

(72) Inventeurs:

- **DI CIOCCIO, Léa**
F-38330 SAINT ISMIER (FR)
- **LETERTRE, Fabrice**
F-38000 GRENOBLE (FR)
- **HUGONNARD-BRUYERE, Elsa**
F-13710 FUYEAU (FR)

(74) Mandataire: **Poulin, Gérard et al**
Brevalex

3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris (FR)

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

EP 1 523 771 B8

- GREGORY R B ET AL: "The effects of damage on hydrogen-implant-induced thin-film separation from bulk silicon carbide" WIDE-BANDGAP SEMICONDUCTORS FOR HIGH-POWER, HIGH-FREQUENCY AND HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS - 1999. SYMPOSIUM, WIDE-BANDGAP SEMICONDUCTORS FOR HIGH-POWER, HIGH-FREQUENCY AND HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS - 1999. SYMPOSIUM, SAN FRANCISCO, CA, USA, 5-, pages 33-38, XP001040858 1999, Warrendale, PA, USA, Mater. Res. Soc, USA
- BINARI S C ET AL: "H, He, and N implant isolation of n-type GaN" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 78, no. 5, 1 septembre 1995 (1995-09-01), pages 3008-3011, XP002185242 ISSN: 0021-8979